111 MRダンパを用いたセミアクティブサスペンションの制御

Gain-scheduled control of semi-active suspention using MR damper

○正 西村 秀和(千葉大) 加山 竜三(千葉大院)

Hidekazu NISHIMURA, Chiba University, Yayoichou1-33, Inage-ku, Chiba Ryozo KAYAMA, Graduate School of Science and Technology, Chiba University, ibid

This paper proposes a design method for vibration isolation control of a semi-active suspension using MR damper. By using nonlinear functions we formulated the linear-parameter-varying system taking account of mechanical constraints such as valve stroke of the semi-active damper and the damping coefficient restriction. The gainscheduled controller based on the linear matrix inequalities is obtained so that the closed-loop system is stable and has good performance even if saturation of the valve stroke occurs. By simulations it is verified that the semi-active damper system designed is effective in comparison with a passive damper. We then made a experimental setup which has an MR damper and investigated characteristics of the MR damper. Furthermore, we proposed the control method of the MR damper using the relation between input current and the damping coefficient.

Key Words: Vibration Isolation, Semi-active Suspention, MR damper, Gain-scheduled control, Linear-parameter-varying system

1. 緒言

路面外乱を車体に伝えないようにする振動絶縁制御問題 に関して、スカイフック制御がアクティブサスペンション やセミアクティブサスペンションに広く適用され、多くの 研究や実用化がなされている.セミアクティブ方式は減衰 係数のみを可変にする方法であるため、アクチュエータ駆 動のための油圧源などを必要とするアクティブ方式に比べ、 よりコストおよびエネルギー消費を抑えることができ、か つ保全性の高いシステムを構築できる利点を有する.

しかし、セミアクティブサスペンションは双線形システムとなるため、 H_{∞} 制御等の線形制御を適用する場合には、アクティブサスペンションとしての制御系設計を施した上で、減衰力で発生可能な力のみを制御入力として用いる方法をとる.このため、スカイフック制御のカルノップ近似則⁽¹⁾同様、減衰力の急激な切替が発生し、乗車する人へ不快感を与えてしまうという問題がある.また力入力として設計しなければばらないために、ハード的に不可能な減衰係数をとる可能性がある.

三平らは非線形H∞制御をセミアクティブサスペンションに応用し,実用化されている⁽²⁾.しかしながら,重み関数の設定にはある種の条件(非線形重みの導入)があり,また出力フィードバック制御系を直接求めていないなどの問題がある.

著者らは減衰係数をバルブ開度により可変とした機構を 想定し、バルブに制約を持たせたセミアクティブダンパの 線形パラメータ変動系に対してGS制御器を設計し、得ら れたGS制御系が外乱の大きさに応じて減衰係数を適切に 切り替えることができ、バネ上およびバネ下固有振動数の 帯域でパッシブダンパより優れた応答低減性能を有するこ とを示した^{(3),(4)}.

一方,磁気粘性流体(Magneto-rheological fluid)を用いた 可変減衰型のMRダンパが開発され、その応用が盛んに行 われている^{(5),(6)}. MRダンパは、コイルに流れる電流によ り流体の粘性を変化させることができ、比較的小さな電圧 で大きな減衰力を得ることができる⁽⁷⁾.

そこで本研究では、実際の車両の質量約1/4サイズの実 験装置を製作し、実験装置の諸元に合わせたGS制御器を再 設計する.さらに、実際の制御に用いる可変減衰型のMR ダンパの特性を評価し、このMRダンパの特性に近い近似 式を導出し、シミュレーションにより考察を行う.

2. 実験装置

実験装置は2自由度の1/4サスペンションモデルで、実際 の質量の1/4を目安に製作した.実験装置の全体図をFig. 1(a)に、1/4サスペンションモデルをFig. 1(b)に示す.バ ネ上質量(車体 M_b)とバネ下質量(車輪 M_w)の間にサスペン ションバネ(K_s)とセミアクティブダンパ(MRダンパ)が 接続されている.また、タイヤ剛性をバネ(K_t)としてい る.この実験装置の諸元をTable 1に示す.

この諸元をもとに実験装置の外乱からバネ上加速度の周 波数応答を実験により測定した結果をFig. 2に示す.ただ し、実験装置にはMRダンパは取り付けていないが、スラ イドベアリングによる摩擦が存在するため、破線で示した 数値計算結果には8Ns/mの減衰を加えてある.これより数 値計算結果と実験結果はほぼ一致していることがわかる.



(a) Experimental setup (b) 1/4 model Fig. 1 Suspention model

Table 1 Parameters of experimental model

Parameter	1/4 model	Exp.*	Unit
M_b	375	91.0	kg
M_w	38	11.8	kg
K_s	21560	5520	N/m
K_t	240000	62980	N/m

日本機械学会〔Na01-72〕第2回ダンピングシンポジウム講演論文集〔2002.1.15,16,東京〕



Fig. 2 Frequency responces of suspention model

3. 制御系設計

3.1 力学モデル

力学モデルは, Fig. 1(b)に示した1/4サスペンションモ デルで,前章にて求めた実験装置の諸元を用いた.セミア クティブダンパの減衰係数を*C*vとすると制御入力uは

$$u = C_v(\dot{x}_w - \dot{x}_b) \qquad (1)$$

となり,状態量を

$$x_{p} = \begin{bmatrix} x_{r} - x_{w} & x_{w} - x_{b} & \dot{x}_{w} & \dot{x}_{b} \end{bmatrix}^{T} \cdots \cdots (2)$$

と定義すると、状態方程式および出力方程式は

となる.ここで、 \dot{x}_r は路面速度外乱である.また、観測出力 としてはバネ上加速度 \ddot{x}_b を用い、制御量には、ストローク 速度 $\dot{x}_w - \dot{x}_b$ 、バネ上加速度 \ddot{x}_b 、バネ上速度 \dot{x}_b を採用する.

3.2 セミアクティブダンパモデル

実際の制御で用いるセミアクティブダンパはMRダンパ であるが、制御系設計のためのモデリングの際にはバルブ 機構を想定したダンパモデルを考える⁽⁴⁾.

セミアクティブダンパの減衰係数 C_v はバルブ開度 x_a に 制約を与えて $\pm \eta$ の範囲内で可変とする.式(4)に関係式を 示し, Fig. 3(a)に図示する.

$$C_v = -\alpha x_a + \beta \quad (-\eta \le x_a \le \eta)$$

$$\alpha, \beta = \text{const.}(>0) \qquad (4)$$

本設計では、 $\eta = 0.01$, $\alpha = 12500$, $\beta = 500$ とする. この 制約とサスペンションのストローク速度の2つをパラメー タとして用いてシステムを線形パラメータ依存モデルへと 変形する.

Fig. 4に示したダンパモデルに基づき,制御入力をe,バルブ開度をxaとすると,その支配方程式はバルブ特性を2次遅れ系と仮定して次式で与える.

$$m_a \ddot{x}_a + \hat{c}_a \dot{x}_a + \hat{k}_a x_a = k_a e \qquad (5)$$



Semi-active damper property



Fig. 3

Fig. 4 Semi-active damper

バルブ開度*x*aに制約を与えるため,式(6)に示す非線形バ ネ*k*aを用いる.この関係をFig.3(b)に図示する.

 \hat{k}_{a} は $|x_{a}| < \eta$ の範囲では k_{a} の値をとり $|x_{a}| \ge \eta$ の範囲では その5倍の値をとるものとする.これにより,バルブ開度 x_{a} が $\pm \eta$ [m]を越えるとバルブが固くなるという制約を加え ることができる.またダンパ \hat{c}_{a} についても同様に

$$\hat{c}_a = \begin{cases} c_a & (|x_a| < \eta) \\ 20 \cdot c_a & (|x_a| \ge \eta) \end{cases}$$
(7)

とする.ただし、制御系設計が複雑になるのを避けるため、 このダンパの非線形性は制御系設計用の線形パラメータ依 存モデルには考慮しないものとする.

3.3 線形パラメータ依存モデルの導出

状態ベクトルを

 $x_s = \begin{bmatrix} x_r - x_w & x_w - x_b & \dot{x}_w & \dot{x}_b & x_a & \dot{x}_a \end{bmatrix}^T \cdots (8)$

とし拡大系を構成すると,状態方程式および出力方程式は

$$\dot{x}_{s} = A_{s}(p_{1}, p_{2})x_{s} + B_{sw}\dot{x}_{r} + B_{su}e y = C_{s}(p_{1})x_{s} \qquad \dots \dots \dots (9) = [\dot{x}_{w} - \dot{x}_{b} \quad \ddot{x}_{b} \quad \dot{x}_{b}]^{T}$$

となる.ここで、 p_1 , p_2 はそれぞれ、サスペンションスト ローク速度およびバルブ開度制約によるスケジューリング パラメータで、次式に示すとおりとなる.

$$p_1 = \dot{x}_w - \dot{x}_b$$

$$p_2 = \hat{k}_a/k_a$$
(10)

これで*p*₁と*p*₂をスケジューリングパラメータとする線形パ ラメータ依存モデルへと変形することができた.ここで, 第3章に示すLMIに基づくGS制御器を設計する上で,*C*_s が時変パラメータに対して,独立でなければならないという条件があるため,プラントの出力端に十分広い帯域幅を もつローパスフィルタを付加することで*C*_s(*p*₁)のパラメー タ依存性をなくし,新たな拡大方程式を構成すると,

と変形できる. A_0 は A_w から2つのスケジューリングパラ メータに対して独立な成分のみを取り出した行列であり, A_1, A_2 はそれぞれ p_1, p_2 に依存する成分を取り出した行列 である.

しかし $p_1=0$ では不可制御となるため、 p_1 の範囲を以下 のように正負2つにわけ、それぞれについてパラメータ依 存モデルを求めた.また $|p_1| \leq 0.001$ の範囲では制御入力 を0とした.これによりスケジューリングパラメータ p_1, p_2 は次の範囲で変化することとなる.

$$p_1^- \in [-0.20, -0.001], p_1^+ \in [0.001, 0.20], \quad (12)$$
$$p_2 \in [1, 5]$$

この関係の略図をFig. 5に示す、得られた線形時不変(LTI) 端点モデルは p_1 の正負で対称性があり、 p_1^- の最大値と p_1^+ の最小値、および p_1^- の最小値と p_1^+ の最大値において、ゲ インが同じで位相が180度ずれたモデルとなる、 p_1^+ 、 p_2 で の最大値、最小値4つの線形時不変(LTI)端点モデルの周波 数応答のゲイン線図をFig. 6に示す。

3.4 GS制御器

前章で作成した線形パラメータ依存モデルに対して、L MIに基づくGS制御を適用する.ここで一般化プラントを Fig. 7のように構成する.周波数重み関数 W_T によって高 周波数領域での制御入力の影響を低減し、周波数重み関数 W_S により、外乱に対する応答を低減する.また観測量と しては、バネ上加速度(\ddot{x}_b)とストローク速度($\dot{x}_w - \dot{x}_b$)であ る.Fig.8に各周波数重み関数のゲイン線図を示す.周波 数重み W_{S1} はサスペンションのストローク速度($\dot{x}_w - \dot{x}_b$), W_{S2} はバネ上加速度(\ddot{x}_b), W_{S3} はバネ上速度(\dot{x}_b)に対する 重みである.ここで、バネ上速度、バネ上加速度を効果的 に抑えるため、 W_{S2} と W_{S3} には5Hz付近に若干のピークを 持たせた.

動作点 $p^*(t)$ (*: -または+) におけるGS制御器は, MAT LAB LMI toolboxを用いて求まるスケジューリングパラメー $タp_1^*$, p_2 においてそれぞれの最大値,最小値である4つの 端点に対応したLTI端点制御器の凸補間によって表わすこ とができる.また設計したLTI端点制御器についても p_1 の 正負において対称性があり,ゲインが同じで,位相が180 度ずれた制御器となる. p_1^+ , p_2 でのLTI端点制御器のボー ド線図をFig.9に示す.



Fig: 5 LPV model



Fig. 6 Frequency responses of LPV model



Fig. 7 Block diagram of generalized plant



Fig. 8 Frequency responses of weight function





Fig. 10 Time history responses by sinusoidal inputs

3.5 数值計算結果

設計されたGS制御器と, C_v をハード($C_h = 625$)とソフト($C_s = 375$)に固定したパッシブダンパとの比較をシミュレーションにより行った.正弦波を路面の速度外乱として入力し,バネ上加速度を評価する.ただし,シミュレーションではバルブが制約内で動くように制御器を設計する際に用いた p_2 を

$$p_{2} = \begin{cases} 1 & (|x_{a}| < \eta) \\ 7 & (|x_{a}| \ge \eta) \end{cases}$$
 (13)

としている. 正弦波の振幅を一定(A = 0.10)で周波数をス イープさせ, それぞれの周波数で定常状態での振幅比を計 算した結果をFig. 10(a)に示す. セミアクティブサスペン ションは, バネ上固有振動数1.2Hzの帯域ではハード固定 のダンパよりも応答を低減しており, 2~10Hzの帯域では ソフト固定のダンパよりも1~2dB程度応答が悪化してい るものの, バネ下固有振動数12Hzの帯域ではソフト固定の ダンパと同等の応答を示している.

次に,外乱周波数1.2Hzのときのストローク速度と減衰 力の関係をFig. 10(b)に示す.このリサージュ波形は減衰係 数として物理的に妥当な値をとる第1象限と第3象限のみ に入っていることがわかる.

Fig. 10(c)~(f)には外乱周波数1.2Hzのときの時刻歴応 答を示す. 減衰係数はストローク速度(p₁)が0m/sにおい て制御器の切換が起こるために急激な変化が見られるが, 生じる減衰力は滑らかに変化している. それによって,バ ネ上加速度も滑らかに振動し,かつ振動低減が見られる.

4. MRダンパの特性と制御

4.1 MR ダンパの概略図

本研究で使用する MR ダンパはLORD 社製(型番:RD1005-5-1)で、この MR ダンパの概略図を Fig. 11に示す.シリン ダー内に磁気粘性流体が封入されており、ピストン内に設 けられたオリフィスにより流体が行き来できるようになっ ている.またピストン内部にはコイルが巻かれており、こ のコイルに電流が流れることにより、磁界が発生し流体が 磁化されることで減衰特性が変化する.このことから、MR ダンパの減衰係数はコイルに流れる電流による関数で表 されるので⁽⁸⁾、この入力電流と減衰力の関係を実験的に求 めた.



Fig. 11 Schematic diagram of MR damper

4.2 一定電流入力

Fig. 12には、実験装置にMRダンパを取り付け、MRダ ンパに一定電流を加えた場合のストローク速度(*x*_w-*x*_b)と 減衰力の関係図を示す.ストローク速度はレーザー変位計 により得られたバネ上質量とバネ下質量の相対変位の一階 微分値,減衰力はひずみゲージを用いて測定している.入 力電流は0.00Aから0.25Aまで0.05A刻みで変化させた.ス トローク速度が比較的小さなところでは急激に減衰力が変 化し、大きなところでは緩やかに変化する.また、入力電 流が増加するに伴って全体的な発生減衰力が増加すること がわかる.

そこで、MRダンパの発生減衰力を式(14)に示すように 近似した. Fは発生減衰力、 $\hat{C}_v(i)$ は電流(i)のみによる関 数である.

 α および $\hat{C}_v(i)$ はFig. 12より式(15)のように求まった. このようにして求めた MR ダンパの近似特性図をFig. 13に示す.

$$\begin{array}{rcl} \alpha & = & 0.2 \\ \hat{C}_v(i) & = & ai^2 + bi + c \end{array} \qquad (15)$$

ここでa, b, cはそれぞれ

である.また, α=0.2という値は文献(8)でも示されており,妥当な値であると考えられる.

4.3 入力電流の変化に対するMRダンパの過渡特性

Fig. 14には、MRダンパの入力電流を変化させたときの 時刻歴応答を示す.(A)にはMRダンパへの入力電流を初 期入力0.00Aから5秒後に0.40Aに増加させた場合,(B)に は初期入力0.40Aから5秒後に0.00Aに減少させた場合を示 す.また(a)~(e)はそれぞれ、実験より測定した減衰力,式 (14)の近似式より計算される減衰力(ただし,ストローク 速度の絶対値が0.001m/s以下では減衰力を0.00Nとしてい る)、5秒付近の減衰力、ストローク速度、ストローク速度 と減衰力のリサージュ波形を示している.(a),(b),(e)よ り実験値と式(14)で導出した近似式はほぼ一致しているこ とがわかる.また(c)より入力電流の変化による減衰力の 時間遅れはそれほど現れていないことがわかる.









4.4 入力電流の計算

2章で求めたGS制御で出力される*C*,からMRダンパへの入力電流を求める.

$$F = \hat{C}_{v}(i)(\dot{x}_{w} - \dot{x}_{b})^{\alpha} = C_{v}(\dot{x}_{w} - \dot{x}_{b}) \quad \cdots \cdots \cdots \quad (17)$$

より

となり,上記の $\hat{C}_v(i)$ を用いて

$$i = f(C_v) = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4a\{c - C_v(\dot{x}_w - \dot{x}_b)^{1-\alpha}\}}}{2a} \quad (19)$$

がMRダンパに入力電流になる.しかしながら,式(19)は $C_v(\dot{x}_w - \dot{x}_b)^{1-\alpha} < c = 50.394$ の場合,式(17)の解は虚数解 となる.従ってその場合は入力電流を0.00Aとする.そのた め, $C_v(\dot{x}_w - \dot{x}_b)^{1-\alpha} < c = 50.394$ の場合に制御性能に悪影 響を及ぼす可能性がある.そこでシミュレーションにより 検証を行った.

シミュレーションは3.5節と同様に振幅0.10m/sの速度外 乱を加え,外乱からバネ上加速度の周波数応答をFig. 15(a) に,外乱周波数1.2Hzの場合のリサージュ波形をFig. 15(b) に示す. (a)には3.5節での周波数応答図と比較している.こ れより周波数応答はそれほど悪化しないことがわかる. また,Fig. 15(c)から(f)に外乱周波数1.2Hzのときの時刻 歴応答を示す.これより減衰力はやや振動的になるが、そ れによる加速度への影響はそれほどみられない.



Fig. 15 Time history responses using MR damper

4.5 制御手法

以上をまとめた制御方法の概略図をFig. 16に示す. フィー ドバック信号はバネ上加速度とし, PC内に取り込み2章で 設計したGS制御器に入力する. またストローク速度の正 負により制御器を切り替え,仮想的に考えたバルブ機構の セミアクティブダンパモデルを介して制御に必要な減衰係 数を出力させる. この減衰係数に見合う入力電流を4章に て導出した近似式により求め, MRダンパに入力を加える.





5. 結言

MRダンパを用いた車両用セミアクティブサスペンショ ンにGS制御を適用することにより、動作条件の変化によっ てMRダンパの発生する減衰力を適切に切り換えるための 制御系設計手法を示した.MRダンパはストローク速度が 大きな所では比較的緩やかに減衰力が変化し、またストロー ク速度が小さなところでは急激に減衰力が変化することが 実験的に示され、入力電流により減衰特性の変化を近似式 を用いて表現した.そして、低周波数帯域ではハード固定 と同程度、高周波数帯域ではソフト固定と同程度の制振性 能を得ることができることをシミュレーションにより示し た.今後は加振実験を行い、本提案手法の有効性を検証す る予定である.

参考文献

- Karnopp, D., Crosby, M. J., Harwood, R. A., Trans. ASME, J. of Eng. for Industry, 619/626, (1974)
- (2) 三平・大作・上村, システム/制御/情報, 43-10(1999), 544-552
- (3) 西村・佐野・尾家,機論(C編), 67-662(2001), 78-84
- (4) 加山・西村・横山,第44回自動制御連合講演会講演論文集,
 (2001),112-118
- (5) 潘·松久·本田, 機論(C編), 67-660(2001), 112-118
- (6) 横山・中村・外山,第13回「電磁気力関連のダイナミクス」 シンポジウム講演論文集,(2001),509-512
- (7) 袖山・砂子田, D&D Conference 2001 CD-ROM論文集, No.507(2001)
- (8) 袖山・砂子田・ほか3名,日本建築学会大会学術講演梗慨集, No.21459(2000)